

МДТКИ-800-12

IGBT
модули

www.elvpr.ru

www.moris.ru/~martin

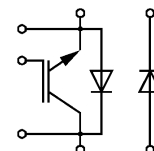
СИЛОВОЙ IGBT МОДУЛЬ

- ♦ одиночный ключ с диодом чоппера (диод может быть подключен как со стороны эмиттера, так и со стороны коллектора с помощью внешних силовых шин)
- ♦ встроенный быстродействующий диод обратного тока
- ♦ корпус с изолированным основанием
- ♦ диагностический вывод коллектора для контроля V_{CE}



ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ♦ преобразователи частоты
- ♦ источники бесперебойного питания
- ♦ сварочное оборудование
- ♦ ПСН подвижного состава железных дорог



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- ♦ $V_{CES} = \underline{1200 \text{ В}}$
- ♦ $I_C = \underline{800 \text{ А}}$ ($T_C = 80 \text{ °C}$)
- ♦ $V_{CESat} = \underline{2.7 \text{ В}}$ (тип.)
- ♦ $I_{Cpuls} = \underline{1600 \text{ А}}$ ($T_C = 80 \text{ °C}$)

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра	Единица измерения
Напряжение коллектор-эмиттер	V_{CE}	1200	В
Напряжение затвор-эмиттер	V_{GE}	± 20	
Постоянный ток коллектора ($T_C = 80 \text{ °C}$)	I_C	800	А
Импульсный ток коллектора ($t_p = 1 \text{ мс}$, $T_C = 80 \text{ °C}$)	I_{Cpuls}	1600	
Постоянный прямой ток, диод обратного тока / диод чоппера	I_F / I_{FC}	800	
Повторяющийся импульсный прямой ток, диод обратного тока / диод чоппера	I_{FRM} / I_{FRMC}	1600	Вт
Суммарная мощность рассеивания ($T_C = 25 \text{ °C}$), IGBT	P_{tot}	5000	
Максимальная температура перехода	T_j	+ 150	°C
Температура хранения	T_{stg}	- 40...+ 125	
Напряжение изоляции ($t = 1 \text{ мин.}$)	V_{isol}	2500	В (эфф)

ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра	Единица измерения
Тепловое сопротивление переход-корпус, IGBT	R_{thjc}	≤ 0.025	°C/Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус, диод обратного тока / диод чоппера	R_{thjCD} / R_{thjCDC}	≤ 0.042	

МДТКИ-800-12

Тепловое сопротивление корпус-охладитель, $\lambda_{paste} = 1 \text{ Вт/м} \cdot \text{°C}$, на модуль (типичное значение)	R_{thck}	0.006	°C/Вт
---	------------	-------	-------

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при 25 °C, если не указано иное значение)

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра			Единица измерения
		мин.	тип.	макс.	
Статические характеристики					
Пороговое напряжение затвор-эмиттер ($V_{GE} = V_{CE}, I_C = 32 \text{ mA}$)	$V_{GE(th)}$	4.5	5.5	6.5	В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($V_{GE} = 15 \text{ V}, I_C = 800 \text{ A}$)	V_{CEsat}				
при $T_j = 25 \text{ °C}$		-	2.7	3.2	
при $T_j = 125 \text{ °C}$	-	3.4	4.0		
Ток утечки коллектор-эмиттер ($V_{CE} = 1200 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$)	I_{CES}				мА
при $T_j = 25 \text{ °C}$		-	16	-	
при $T_j = 125 \text{ °C}$	-	80	-		
Ток утечки затвор-эмиттер ($V_{GE} = 20 \text{ V}, V_{CE} = 0 \text{ V}$)	I_{GES}	-	-	400	нА
Характеристики на переменном токе					
Входная емкость ($V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ МГц}$)	C_{ies}	-	55	-	нФ
Характеристики переключения (индуктивная нагрузка, при $T_j = 125 \text{ °C}$)					
Время включения ($V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, I_C = 800 \text{ A}, R_G = 1.2 \text{ Ом}$)	t_{on}				мкс
при $T_j = 25 \text{ °C}$		-	0.7	-	
при $T_j = 125 \text{ °C}$	-	0.8	-		
Время задержки выключения ($V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, I_C = 800 \text{ A}, R_G = 1.2 \text{ Ом}$)	$t_{d(off)}$				
при $T_j = 25 \text{ °C}$		-	0.9	-	
при $T_j = 125 \text{ °C}$	-	1.0	-		
Время спада ($V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, I_C = 800 \text{ A}, R_G = 1.2 \text{ Ом}$)	t_f				мкс
при $T_j = 25 \text{ °C}$		-	0.1	-	
при $T_j = 125 \text{ °C}$	-	0.15	-		
Энергия потерь при включении ($V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, I_C = 800 \text{ A}, R_G = 1.2 \text{ Ом}, T_j = 125 \text{ °C}, L_S = 70 \text{ нГн}$, за один импульс)	E_{on}	-	130	-	мДж
Энергия потерь при выключении ($V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, I_C = 800 \text{ A}, R_G = 1.2 \text{ Ом}, T_j = 125 \text{ °C}, L_S = 70 \text{ нГн}$, за один импульс)	E_{off}	-	120	-	

МДТКИ-800-12

Ток короткого замыкания ($t_p \leq 10$ мкс, $V_{CC} = 900$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В, $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{\sigma(CE)} \times di/dt$, $T_j = 125$ °С)	I_{SC}	-	4000	-	А
Внутренняя индуктивность модуля по цепи коллектор-эмиттер	$L_{\sigma(CE)}$	-	20	-	нГн

Характеристики диода обратного тока

Прямое падение напряжения ($I_F = 800$ А, $V_{GE} = 0$ В) при $T_j = 25$ °С при $T_j = 125$ °С	V_F	-	2.2 2.0	2.7 2.5	В
Ток обратного восстановления ($I_F = 800$ А, $V_{GE} = -10$ В, $V_R = 600$ В, $di_F/dt = -4000$ А/мкс) при $T_j = 25$ °С при $T_j = 125$ °С	I_{rr}	-	250 400	-	А
Время обратного восстановления ($I_F = 800$ А, $V_{GE} = -10$ В, $V_R = 600$ В, $di_F/dt = -4000$ А/мкс, $T_j = 125$ °С)	t_{rr}	-	0.45	-	мкс
Заряд обратного восстановления ($I_F = 800$ А, $V_{GE} = -10$ В, $V_R = 600$ В, $di_F/dt = -4000$ А/мкс) при $T_j = 25$ °С при $T_j = 125$ °С	Q_{rr}	-	26 90	-	мкКл

Характеристики диода чоппера

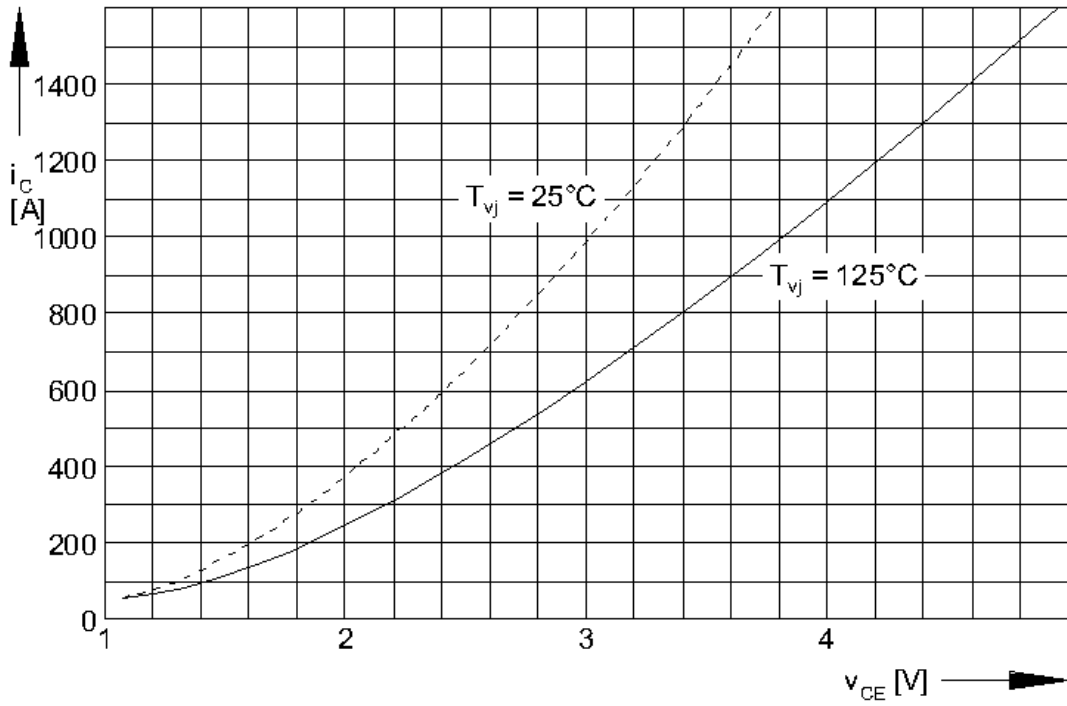
Прямое падение напряжения ($I_F = 800$ А, $V_{GE} = 0$ В) при $T_j = 25$ °С при $T_j = 125$ °С	V_{FC}	-	2.2 2.0	2.7 2.5	В
Ток обратного восстановления ($I_F = 800$ А, $V_{GE} = -10$ В, $V_R = 600$ В, $di_F/dt = -4000$ А/мкс) при $T_j = 25$ °С при $T_j = 125$ °С	I_{rrc}	-	250 400	-	А
Время обратного восстановления ($I_F = 800$ А, $V_{GE} = -10$ В, $V_R = 600$ В, $di_F/dt = -4000$ А/мкс, $T_j = 125$ °С)	t_{rrc}	-	0.45	-	мкс
Заряд обратного восстановления ($I_F = 800$ А, $V_{GE} = -10$ В, $V_R = 600$ В, $di_F/dt = -4000$ А/мкс) при $T_j = 25$ °С при $T_j = 125$ °С	Q_{rrc}	-	26 90	-	мкКл

МДТКИ-800-12

Типовые выходные характеристики

$$I_C = f(V_{CE})$$

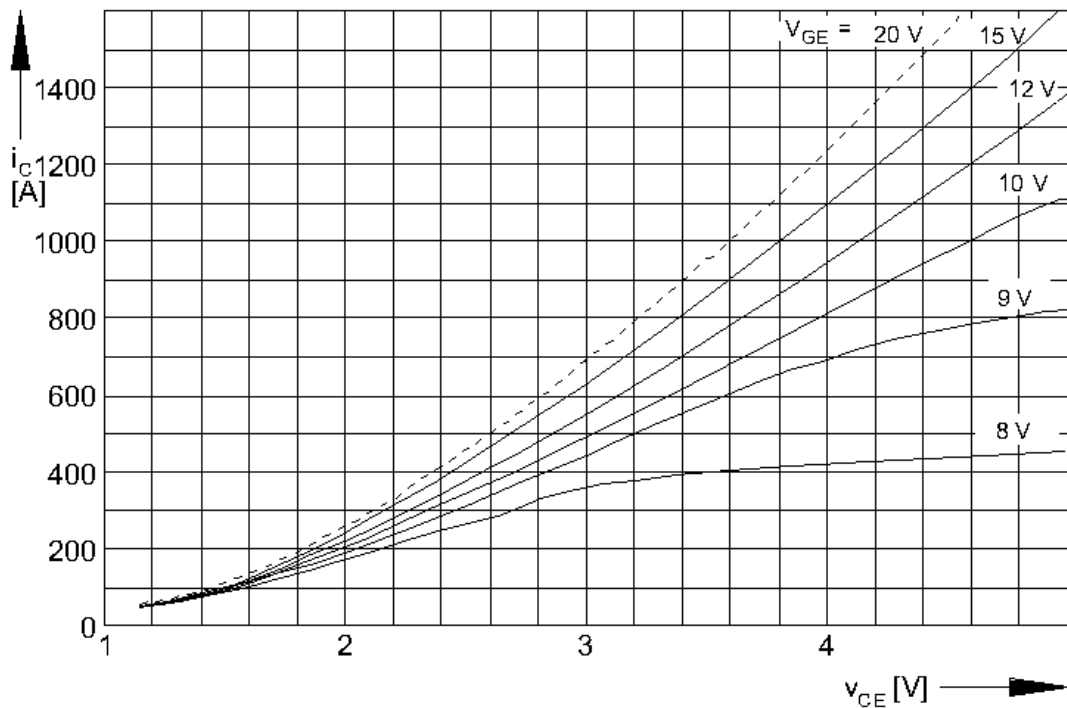
Режим измерения: $V_{GE} = +15 \text{ В}$, $T_j = 25, 125 \text{ }^\circ\text{C}$



Типовые выходные характеристики

$$I_C = f(V_{CE})$$

Режим измерения: $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$

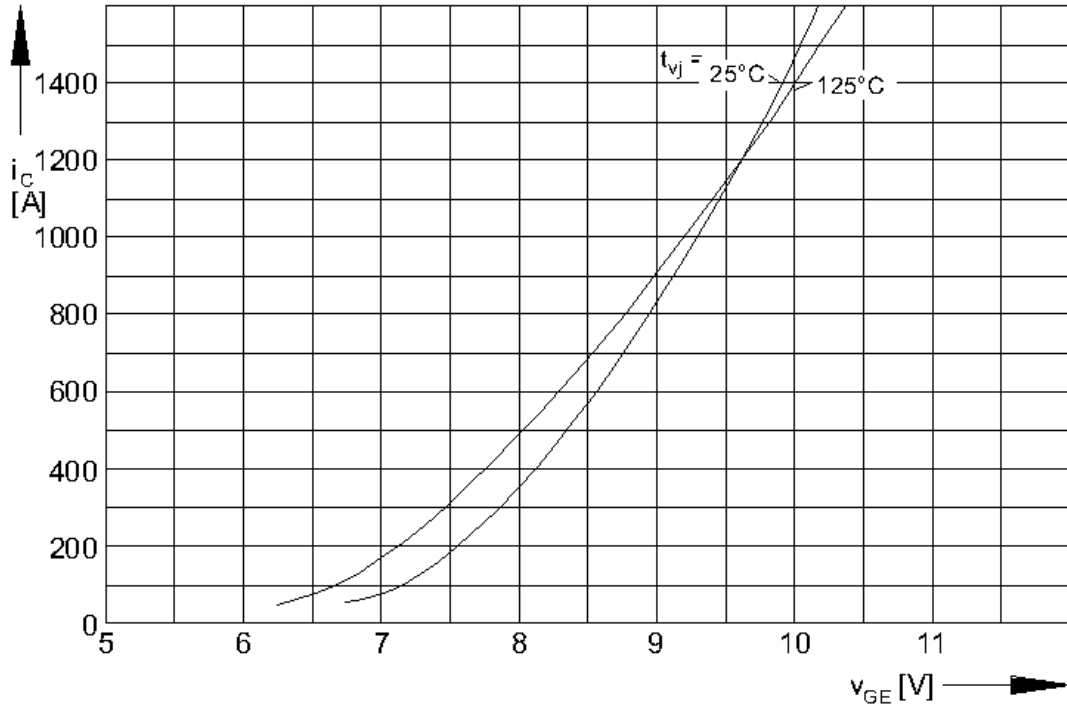


МДТКИ-800-12

Типовые передаточные характеристики

$$I_C = f(V_{GE})$$

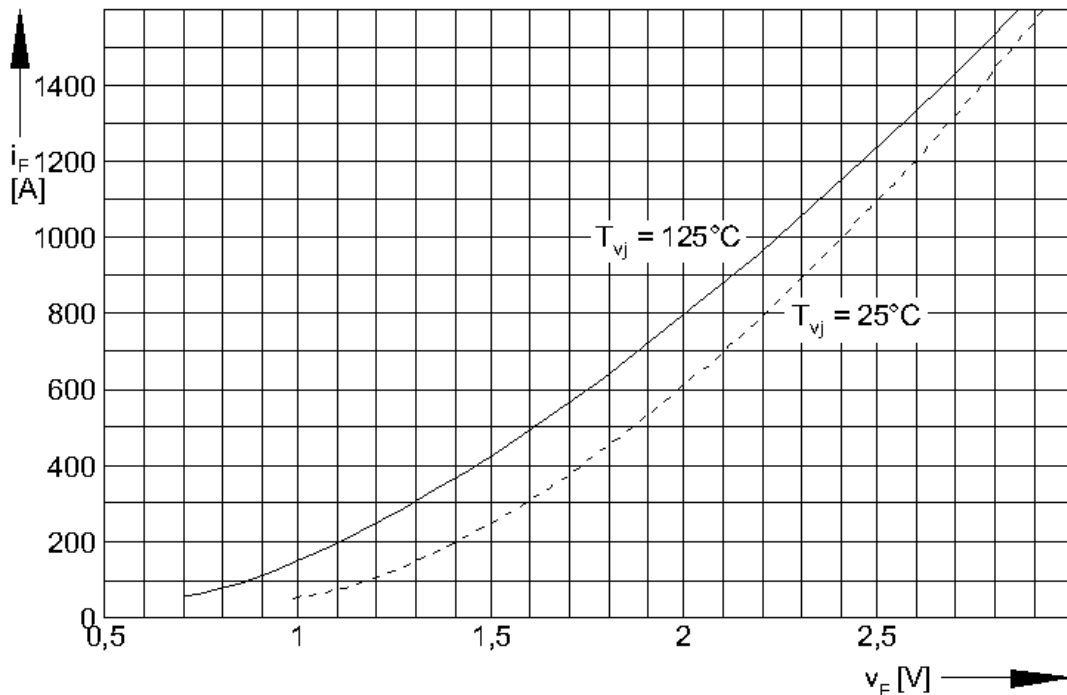
Режим измерения: $V_{CE} = 20 \text{ В}$, $T_j = 25, 125 \text{ }^\circ\text{C}$



Типовые прямые характеристики диода обратного тока

$$I_F = f(V_F)$$

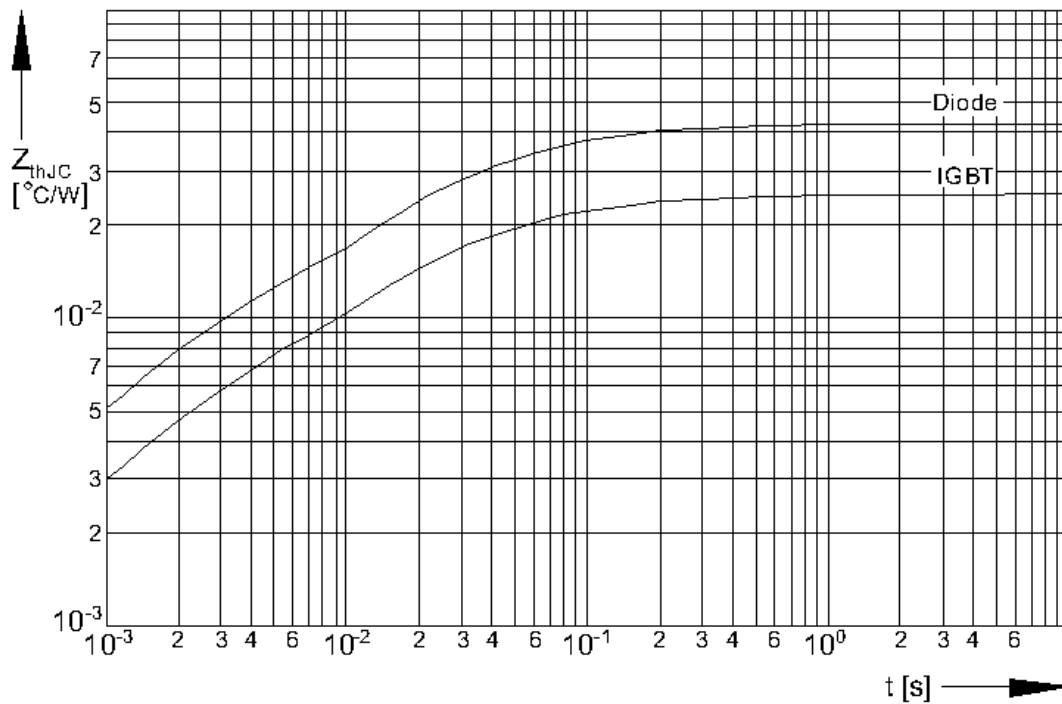
Режим измерения: $T_j = 25, 125 \text{ }^\circ\text{C}$



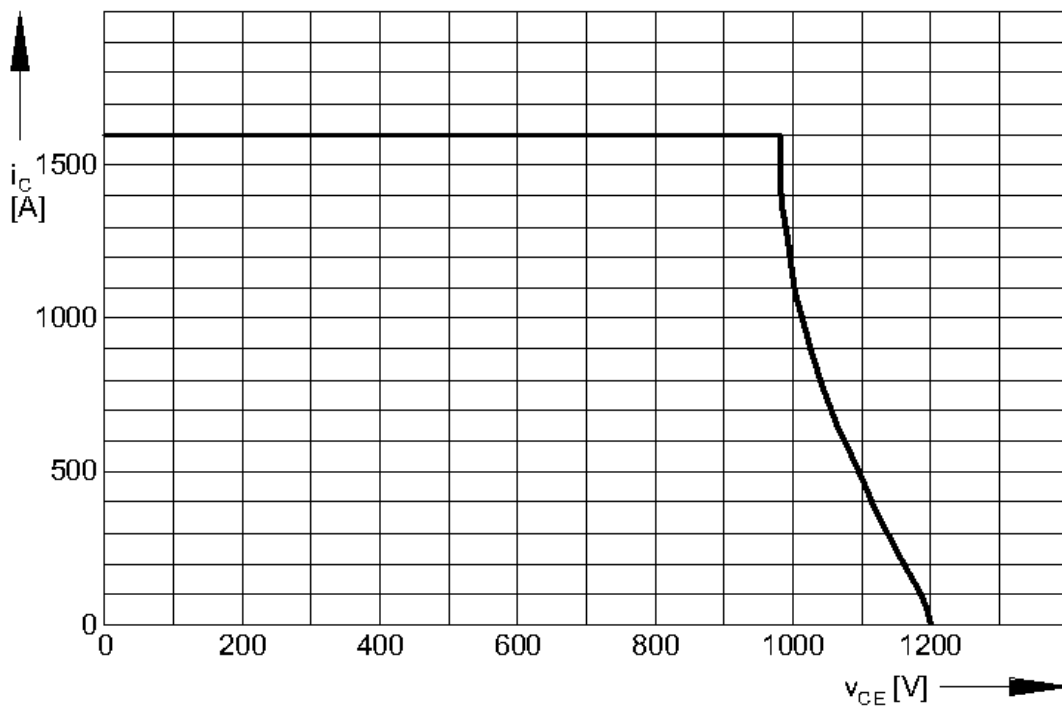


МДТКИ-800-12

Переходное тепловое сопротивление
 $Z_{thjc} = f(t_p)$

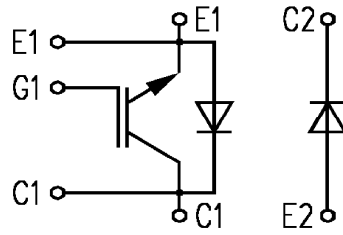


Обратная область безопасной работы
 $I_{C\text{ puls}} = f(V_{CE})$
 Режим измерения: $R_C = 1.2 \text{ Ом}$, $T_j = 125 \text{ }^{\circ}\text{C}$

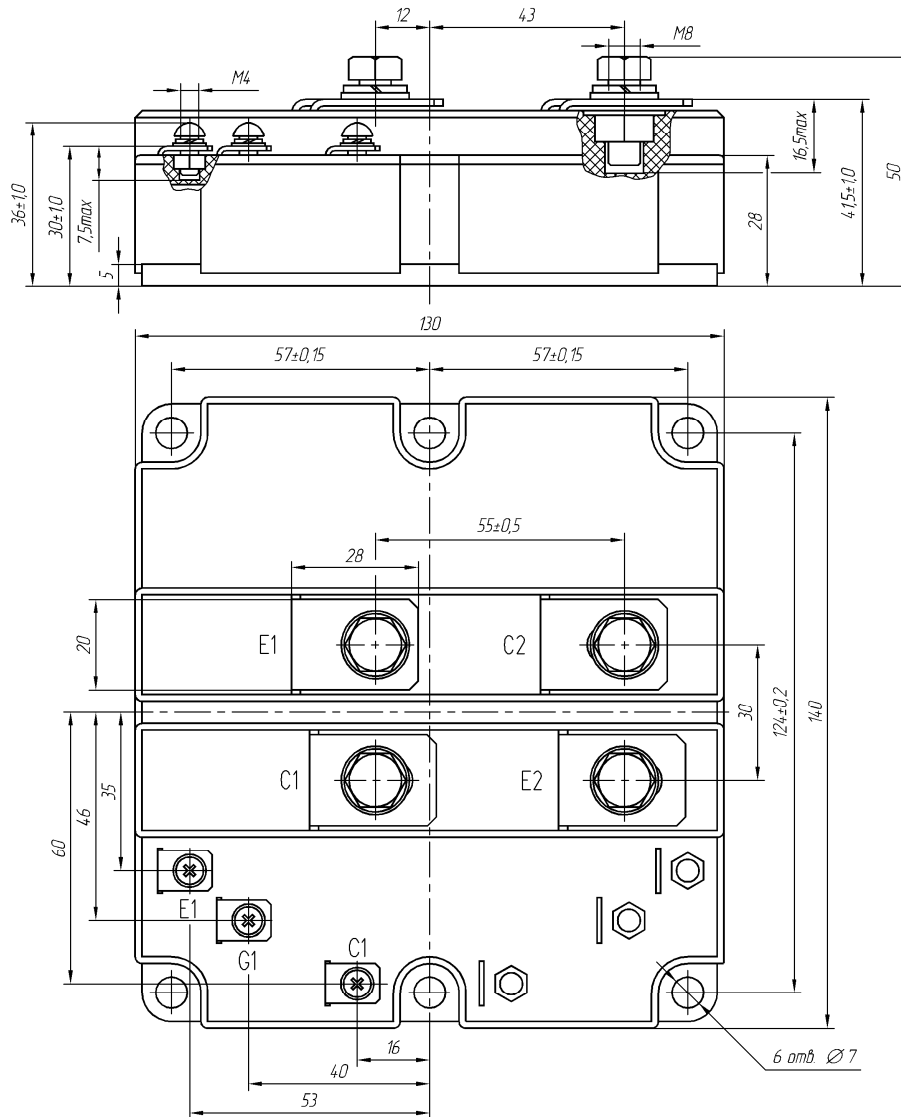


МДТКИ-800-12

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Масса 1.5 кг